XVII Российская конференция по физике полупроводников

Москва , 5–9 октября 2026 года

Программа

Актуальная версия программы находится в личном кабинете на сайте конференции.

Москва, 2026

Организаторы конференции

— Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН;
— Отделение физических наук РАН;
— Научный совет РАН по физике полупроводников;
— Российская академия наук.

Программный комитет

— **Е. Л. Ивченко**, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург — **председатель**;
— **М. М. Глазов**, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург — **ученый секретарь**;
— **В. Л. Альперович**, ИФП СО РАН, Новосибирск;
— **А. А. Андронов**, ИФМ РАН, Нижний Новгород;
— **А. Л. Асеев**, ИФП СО РАН, Новосибирск;
— **В. А. Волков**, ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Москва;
— **В. И. Гавриленко**, ИФМ РАН, Нижний Новгород;
— **А. А. Гиппиус**, ФИАН, Москва;
— **А. А. Горбацевич**, ФИАН, Москва;
— **А. В. Двуреченский**, ИФП СО РАН, Новосибирск;
— **Э. В. Девятов**, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черноголовка;
— **А. Г. Забродский**, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург;
— **С. В. Зайцев-Зотов**, ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Москва;
— **С. В. Иванов**, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург;
— **В. В. Кведер**, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черноголовка;
— **З. Д. Квон**, ИФП СО РАН, Новосибирск;
— **П. С. Копьев**, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург;
— **З. Ф. Красильник**, ИФМ РАН, Нижний Новгород;
— **Г. Я. Красников**, президент РАН;
— **И. В. Кукушкин**, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черноголовка;
— **В. Д. Кулаковский**, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черноголовка;
— **Л. В. Кулик**, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черноголовка;
— **Ю. Г. Кусраев**, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург;
— **А. В. Латышев**, ИФП СО РАН, Новосибирск;
— **В. М. Муравьев**, ИФТТ им. Ю. А. Осипьяна РАН, Черноголовка;
— **И. Г. Неизвестный**, ИФП СО РАН, Новосибирск;
— **В. И. Окулов**, ИФМ им. М. Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург;
— **В. Я. Покровский**, ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, Москва;
— **А. А. Саранин**, ИАПУ ДВО РАН, Владивосток;
— **А. С. Терехов**, ИФП СО РАН, Ноосибирск;
— **С. Г. Тиходеев**, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва;
— **Д. Р. Хохлов**, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва;
— **Г. Э. Цырлин**, СПбАУ им. Ж. И. Алферова РАН, Санкт-Петербург;
— **А. В. Чаплик**, ИФП СО РАН, Новосибирск.

Организационный комитет

- **Н. Н. Колачевский**, ФИАН, Москва — **председатель**;
- **В. С. Кривобок**, ФИАН, Москва — **заместитель председателя;**
- **А. А. Пручкина**, ФИАН, Москва;
- **Ю. Е. Чечукова**, ФИАН, Москва;
- **С. Н. Николаев**, ФИАН, Москва;
- **Д. А. Зазымкина**, ФИАН, Москва;
- **А. Р. Дубовая**, ФИАН, Москва;
- **С. А. Савинов**, ФИАН, Москва;
- **Д. Ф. Аминев**, ФИАН, Москва;
- **С. И. Ченцов**, ФИАН, Москва;
- **А. И. Шарков**, ФИАН, Москва;
- **Н. Ю. Фролов**, ФИАН, Москва;
- **А. В. Иконников**, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва;
- **С. А. Димитриева**, ФИАН, Москва;
- **Н. В. Пестовский**, ФИАН, Москва;
- **И. И. Усманов**, ФИАН, Москва.

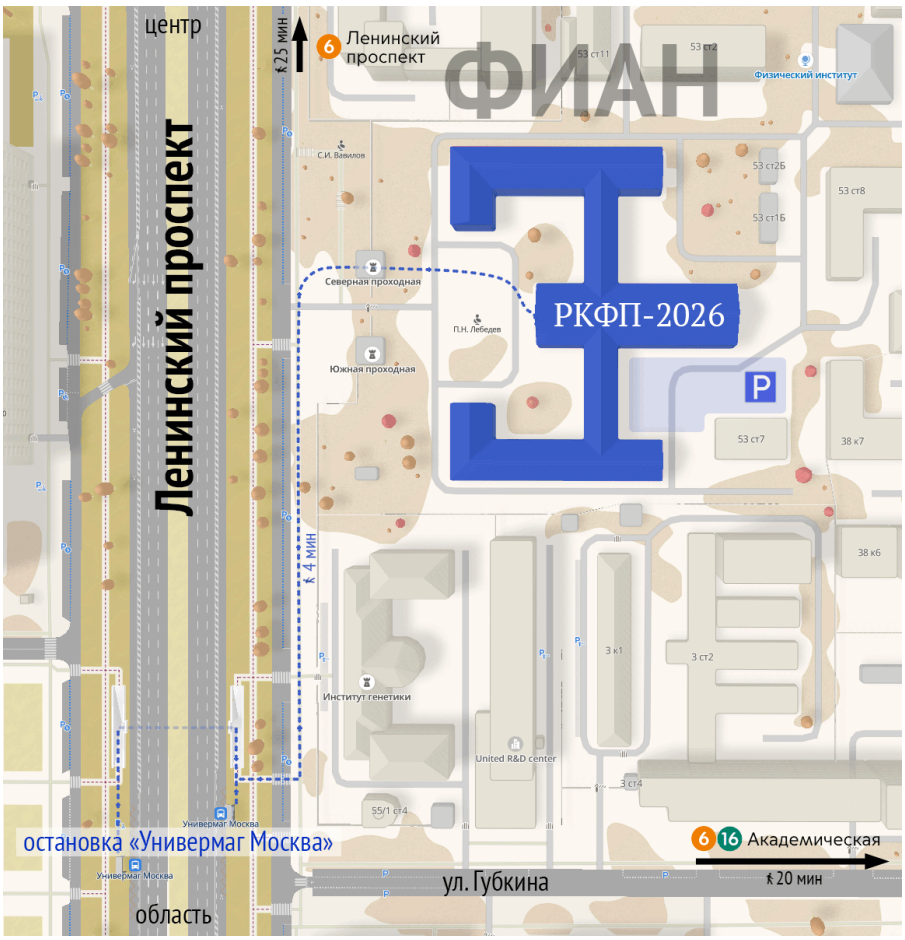
Место проведения

Конференция проходит в главном корпусе ФИАН (Ленинский пр. 53, стр. 4).

Проще всего до него добраться от остановки «Универмаг Москва» (4 минуты пешком).

Ближайшая станция метро — 6 16 Академическая (20 минут пешком).

Для прохода на территорию ФИАН необходим **паспорт гражданина РФ**.



Партнеры конференции

5 октября, понедельник

	Холл главного корпуса
9:00–10:30	**9:00** **Регистрация участников**

	Зал А
10:30–11:00	**10:30** **Открытие конференции**
11:00–12:20	**Пленарное заседание 1** *Председатель — Е. Л. Ивченко*
	11:00 Яковлев Дмитрий Робертович Спиновая физика перовскитных полупроводников
	11:40 Леденцов Николай Николаевич Вертикально-излучающие лазеры: состояние и перспективы
12:30–14:00	**12:30** **Обед**

14:00–15:40	Зал А	Зал Б
	2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки 1 *Председатель — В. И. Гавриленко*	**Топология в полупроводниках 1** *Председатель — Э. В. Девятов*
	14:00 **Ткаченко В. А.**, Ткаченко О. А., Бакшеев Д. Г. Новые проявления одночастичной когерентности в мезоскопическом транспорте	**14:00** **Квон З. Д.**, Брагинский Л. А., Энтин М. В., Ярошевич А. С. Микроволновый отклик сетки топологических каналов в HgTe квантовых ямах критической толщины
	14:25 **Жданов Е. Ю.**, Буданцев М. В., Сарыпов Д. И., Похабов Д. А., Бакаров А. К., Погосов А. Г. V-образные зануления осцилляций Шубникова–де Гааза в высокоподвижных гетероструктурах GaAs/AlGaAs	**14:25** **Терещенко О. Е.**, Голяшов В. А., Бобин С. Б., Лончаков А. Т., Степина Н. П., Кумар Н., Еремеев С. В., Тарасов А. В., Естюнин Д. А., Климовских И. И., Шикин А. М. HgSe vs HgTe: дираковский или вейлевский полуметалл?
	14:40 **Милёхин А. Г.**, Милёхин И. А., Тараненко А. В., Киселев К., Васильев Р. Б., Дворецкая Л. Н., Мухин И. С., Чиглинцев Э. О., Чернов А. И., Гайдук А. Е., Подшивайлов Э. А., Французов П. А., Латышев А. В. Наноскопия одиночных полупроводниковых наноструктур с пространственным и временным разрешением	**14:40** **Ненашев А. В.** Простой взгляд на двумерные топологические изоляторы

14:00—15:40	**14:55** **Дричко И. Л.**, Смирнов И. Ю., Гальперин Ю. М., Суслов А. В. АС-кондактанс в структуре *n*-InAlSb/InSb/InAlSb. Акустические исследования	**14:55** **Макарова Т. П.**, Естюнин Д. А., Голяшов В. А., Кох К. А., Терещенко О. Е., Шикин А. М. Управление топологической фазой и положением точки Дирака в $Mn_{1-x}Pb_xBi_{2-y}Sb_yTe_4$
	15:10 **Фролов Н. Ю.**, Клоков А. Ю., Шарков А. И., Кривобок В. С., Клековкин А. В., Ерошенко Г. Н., Минаев И. И. Исследование особенностей взаимодействия когерентных фононов со светом в короткопериодных сверхрешетках InAs/GaSb	**15:10** Чмырь С. Н., Галеева А. В., Долженко Д. Е., Кристовский К. Г., Артамкин А. И., Иконников А. В., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А., Банников М. И., **Хохлов Д. Р.** Температурная зависимость амплитуды терагерцовой фотопроводимости в структурах на основе $Hg_{1-x}Cd_xTe$
	15:25 **Минаев И. И.**, Клековкин А. В., Ерошенко Г. Н., Свиридов Д. Е., Савин К. А., Кривобок В. С., Пашкеев Д. А., Николаев С. Н. Исследование с помощью микроскопии сопротивления растекания тока барьерно-диодных гетероструктур A3B5	**15:25** **Ниязов Р. А.**, Крайнов И. В., Аристов Д. Н., Качоровский В. Ю. Немагнитный механизм обратного рассеяния на диффузионных островках в геликоидальных краевых состояниях
15:45—16:00	**15:45** **Кофе-брейк**	

16:00—17:40

2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки 2

Председатель — Н. С. Аверкиев

16:00 **Ковалев В. М.,** Снегирев А. В., Энтин М. В., Квон З. Д., Ольшанецкий Е. Б., Левин А. Д., Читта В. А., Гусев Г. М., Михайлов Н. Н.

Температурное поведение сопротивления двумерных систем, обусловленное межчастичным рассеянием носителей заряда

16:25 **Гуняга А. А.,** Дурнев М. В.

Орбитальный фотоиндуцированный эффект Фарадея в решётке проводящих дисков

16:40 **Мыльников В. Ю.,** Качоровский В. Ю.

Обратный эффект Фарадея в нанокольцах с дираковскими фермионами

16:55 **Брагинский Л. С.,** Энтин М. В.

Теория поверхностного фототока в гетеропереходах полупроводников в области экситонного поглощения

Объемные полупроводники, перовскиты, органические полупроводники 1

Председатель — А. А. Лебедев

16:00 **Юдсон В. И.**

Электронный транспорт в слабо легированных системах

16:25 **Жевстовских И. В.,** Морозова Н. В., Коробейников И. В., Сарычев М. Н., Сухих Т. С., Семенова О. И.

Эффекты квазигидростатического давления в электрических и оптических свойствах галогенидных перовскитов

16:40 **Кузнецова М. С.,** Батаев М. Н., Игнатьев И. В., Колобкова Е. В.

Нелинейные эффекты при двухфотонном возбуждении фотолюминесценции нанокристаллов перовскита $CsPbX_3$, внедрённых в стеклянную матрицу

16:55 **Авдеев И. Д.**

Модель Китинга поля валентных сил для ионных кристаллов халькогенидов свинца

16:00–17:40	**17:10** **Аксенов С. В.,** Шустин М. С., Бурмистров И. С. Диссипативное управление откликом в майорановской проволоке	**17:10** **Торопин А. В.,** Гуленков В. Е., Никитенко В. Р. Универсальный транспортный уровень для теоретического описания прыжкового транспорта в неупорядоченных органических полупроводниках
	17:25 **Горбенко И. В.,** Качоровский В. Ю. Управляемый dc током плазменный кристалл: усиление оптического сигнала и срыв в неустойчивость	**17:25** **Клоков А. Ю.,** Фролов Н. Ю., Шарков А. И., Покровский В. Я., Никитин М. В., Зыбцев С. Г. Применение фемтосекундной оптической методики накачка-зондирование для исследования анизотропии упругих свойств ленточных вискеров NbS_3
17:40–20:00	**Стендовая сессия 1**	
	Поверхность, пленки, слои **Высокочастотные явления в полупроводниках** **Атомарно-тонкие полупроводники, наномеханика** **Фотонные кристаллы, метаматериалы, нанофотоника, оптомеханика** **Полупроводниковые приборы и устройства**	
	Приветственный фуршет	

6 октября, вторник

	Зал А	Зал Б
9:30—11:10	**2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки 3** *Председатель — В. М. Ковалев*	**Поверхность, пленки, слои** *Председатель — С. В. Зайцев-Зотов*
	9:30 **Тарасенко С. А.** Эффекты взаимодействия структурированного света с полупроводниками	**9:30** Рожков С. А., Бакин В. В., Русецкий В. С., Горшков Д. В., Кустов Д. А., Казанцев Д. М., Голяшов В. А., Шайблер Г. Э., **Альперович В. Л.**, Терещенко О. Е. Преломление траекторий электронов на скачке массы при фотоэмиссии из полупроводников
	9:55 **Кореев А. С.**, Ваньков А. Б., Бережной П. С. Спиновая структура двумерных электронных систем в окрестности $\nu = 1$	**9:55** **Лендяшова В. В.**, Талалаев В. Г., Кириленко Д. А., Калиничев А. А., Шугабаев Т., Поздеев В. А., Андреева А. С., Резник Р. Р., Цырлин Г. Э., Илькив И. В. Светоизлучающие гетероструктуры на основе квантовых точек InAs на темплейтах GaAs/Si(100)
	10:10 **Румянцев В. В.**, Мажукина К. А., Алешкин В. Я., Дубинов А. А., Уточкин В. В., Горячкина Е. Ю., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А., Морозов С. В.. Стимулированное излучение в гетероструктурах на основе HgCdTe с квантовыми ямами при оптической накачке импульсами различной длительности	**10:10** **Спирина А. А.**, Шварц Н. Л. Влияние направления разориентации подложек GaAs{111} на развитие рельефа поверхности при отжигах (Монте-Карло моделирование)

9:30—11:10	**10:25** **Мажукина К. А.,** Алешкин В. Я., Дубинов А. А., Уточкин В. В., Горячкина Е. Ю., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А., Морозов С. В., Румянцев В. В. Характеристики стимулированного излучения в лазерных структурах с квантовыми ямами CdHgTe/HgCdTe при различных длинах волн оптической накачки	**10:25** **Корякин А. А.,** Шарофидинов Ш. Ш., Гридчин В. О., Дворецкая Л. Н., Котляр К. П., Штром И. В., Цырлин Г. Э. Механизмы фасетирования при селективном росте колончатых микрокристаллов GaN
	10:40 **Курмачев Д. А.,** Квон З. Д., Михайлов Н. Н.. Аномальные флуктуации кондактанса в мезоскопических проводниках на основе сильно разупорядоченного двумерного полуметалла в квантовых ямах HgTe	**10:40** **Соловова Н. Ю.,** Голяшов В. А., Еремеев С. В., Терещенко О. Е. Особенности роста и электронная структура Na2KSb(Cs) фотокатодов
	10:55 **Алешкин В. Я.,** Дубинов А. А Влияние легирования на оже-рекомбинацию в узкозонных квантовых ямах гетероструктур HgTe/CdHgTe	**10:55** **Михайлов Н. Н.,** Дворецкий С. А., Варавин В. С., Ремесник В. Г., Ступак М. Ф., Макаров С. Н., Елесин А. Г. Температурная стабильность фотоэлектрических, оптических и структурных свойств HgCdTe множественных квантовых ям
11:15—11:30	**11:15** **Кофе-брейк**	

11:30—13:30

2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки 4

Председатель — М. А. Семина

11:30

Заболотных А. А., Муравьев В. М.

Плазменные колебания в 2D электронной системе в форме периодического массива полос

11:45

Загороднев И. В., Заболотных А. А., Матвеев А. А., Родионов Д. А., Архипова О. Ю., Калябин Д. В., Сафин А. Р., Никитов С. А.

Гибридизация магнонного с циклотронным и плазменным резонансами 2D электронного газа вблизи магнетика

12:00

Свинцов Д. А., Атласов В. Р., Капралов К. Н.

Электромагнитный механизм чувствительности фототока двумерных систем к направлению волнового фронта

12:15

Родионов Д. А., Загороднев И. В.

Усиленный плазмонами эффект увлечения в проводящей двумерной полосе

0D системы

Председатель — А. В. Новиков

11:30

Смирнов Д. С., Леппенен Н. В., Манцевич В. Н., Ивченко Е. Л.

Теория генерации максимально запутанных фотонов полупроводниковыми системами с квантовыми точками

11:55

Котова Л. В., Абдукадыров А. Г., Кочерешко В. П., Ивченко Е. Л.

Особенности поляризованной люминесценции ансамбля локализованных экситонов

12:10

Галимов А. И., Крайнов И. В., Рахлин М. В., Серов Ю. М., Вейшторт Г. П., Торопов А. А., Шубина Т. В.

Многофотонные состояния из квантовой точки с трионом и нейтральным экситоном в микрорезонаторе

15:00—16:45

12:30 **Морозов А. А.,** Зарезин А. М., Муравьев В. М., Кукушкин И. В.

Плазменные моды в финитных плазмонных кристаллах

12:45 **Фатеев Д. В.,** Полищук О. В., Попов В. В.

Краевые эффекты в двумерных плазмонных резонаторах

13:00 **Моисеенко И. М.,** Девизорова Ж. А., Полищук О. В., Муравьев В. М., Свинцов Д. А.

Плазмонные моды в двумерной электронной системе с щелевым резонатором

13:15 **Джикирба К. Р.,** Шуваев А., Худайбердиев Д., Астраханцева А. С., Кукушкин И. В., Муравьев В. М.

Плазмонный отклик метаповерхности, созданной решеткой из двумерных электронных полос

12:25 **Смирнова О. О.** Родина А. В.

Поляризованная экситонная фотолюминесценция ансамбля полупроводниковых коллоидных наноплателетов

12:40 **Васильев Р. Б.**, Куртина Д. А., Платонова М. Ю., Лебедев А. И

Модификация поверхности атомарно тонких полупроводников $A^{II}B^{VI}$ для управления 2D экситонами

12:55 **Головатенко А. А.,** Русских К. И., Родина А. В.

Двухфотонный линейно-круговой дихроизм в нанокристаллах InP/ZnSe

13:10 **Некрасов С. В.**, Калитухо И. В., Рагоза М. Д., Михайленко Н. О., Кузнецова Я. А., Головатенко А. А., Шамирзаев Т. С., Кусраев Ю. Г.

Влияние промежуточных состояний на спиновую динамику экситона в непрямозонных в *k*-пространстве квантовых точках (In,Al)As/AlAs

13:35—15:00

13:35 **Обед**

15:00—16:40

Высокочастотные явления в полупроводниках

Председатель — В. Я. Покровский

15:00 **Андреева С. А.,** Щепетильников А. В., Джикирба К. Р., Гаврилов А. А., Орлов О. В., Соловьев В. В., Кукушкин И. В.

Плазмоны в низкоразмерных полупроводниках и сверхпроводниках: первое наблюдение плазменных волн в сверхпроводнике

15:25 **Андреев И. В.,** Шинко И. С., Казаков А. С., Муравьев В. М., Кукушкин И. В.

Визуализация двумерных плазмонов при помощи пространственно-разрешенной методики оптического детектирования микроволнового поглощения

15:40 **Титова Е. И.,** Кащенко М. А., Титченко А., Шеин К., Титова М. И., Новоселов К., Гайдученко И., Бандурин Д. А., Свинцов Д. А.

Сверхбыстрые и малошумящие терагерцовые детекторы на основе графена

15:55 **Гайдученко И. А.,** Титченко А. Н., Титова М. И., Попова О. Г., Шеин К. В., Титова Е. И., Измайлов Р. И., Гольцман Г. Н., Бандурин Д. А.

Разработка и демонстрация терагерцового графенового детектора на кремниевой волноводной платформе

Фотонные кристаллы, метаматериалы, нанофотоника, оптомеханика 1

Председатель — С. Г. Тиходеев

15:00 **Шубин Н. М.,** Капаев В. В., Горбацевич А. А.

Связанные состояния в континууме как искусственные атомы: гигантское туннельное расщепление и виртуальные резонансы Фано

15:25 **Перетокин А. В.,** Степихова М. В., Дьяков С. А., Юрасов Д. В., Шалеев М. В., Шенгуров Д. В., Родякина Е. Е., Новиков А. В.

Поляризационные свойства люминесцентного отклика фотонных кристаллов с гексагональной решеткой: от линейной до циркулярной и вихревой поляризации

15:40 **Захаров В. Е.,** Яблонский А. Н., Юрасов Д. В., Шалеев М. В., Шенгуров Д. В., Вербус В. А., Родякина Е. Е., Смагина Ж. В., Дьяков С. А., Новиков А. В.

Пространственное распределение излучения различных мод в двумерных фотонных кристаллах

15:55 **Вяткин Е. С.,** Тарасенко С. А.

Генерация второй гармоники в закрученной двухслойной фотонной структуре

15:00—16:40	**16:10** **Трухин В. Н.,** Малевич В. Л., Мустафин И. А., Фань С., Калиновский В. С., Контрош Е. В. Генерация терагерцового излучения в p-i-n диоде AlGaAs/GaAs при высоком уровне возбуждения	**16:10** Ушанов В. И., Поленок Е. Д., Берт Н. А., Еремеев С. В., Силкин В. М., Преображенский В. В., Путято М. А., Семягин Б. Р., **Чалдышев В. В.** Локализованный плазмонный резонанс в системах наночастиц Bi, Sb, As и P в AlGaAs
	16:25 Рожков А. В., Слободнюк А. С., Смирнова И. А., **Родин П. Б.** Спонтанные высокочастотные автоколебания в лавинных диодах на основе кремния и арсенида галлия	**16:25** **Поленок Е. Д.,** Берт Н. А., Яговкина М. А., Преображенский В. В., Путято М. А., Семягин Б. Р., Ушанов В. И., Чалдышев В. В. Когерентное брэгговское рассеяние света на упорядоченном массиве плазмонных наночастиц Bi в матрице GaAs
16:45—17:00	**16:45** **Кофе-брейк**	

17:00—18:30

Объемные полупроводники, перовскиты, органические полупроводники 2 *Председатель — В. И. Юдсон*	Полупроводниковые приборы и устройства 1 *Председатель — В. С. Кривобок*
17:00 **Капогузов К. Е.,** Мутилин С. В., Милюшин Д. М., Волошин Б. В., Лысенко Н. И., Кичай В. Н., Яковкина Л. В., Косинова М. Л., Селезнев В. А. Нанопереключатели на основе VO_2 для энергоэффективных нейроморфных вычислений	**17:00** **Копытов П. Е.,** Ковач Я. Н., Блохин С. А., Андрюшкин В. В., Бабичев А. В., Гладышев А. Г., Воропаев К. О., Новиков И. И., Карачинский Л. Я., Егоров А. Ю. Высокоскоростные вертикально-излучающие лазеры диапазона 1300–1550 нм, изготовленные методами молекулярно-пучковой эпитаксии и спекания пластин
17:15 Калинушкин В. П., **Миронов С. А.,** Гладилин А. А, Уваров О. В., Юрьев В. А., Ильичев Н. Н., Туморин В. В., Гулямова Э. С., Чегнов В. П., Горшунов Б. П., Жукова Е. С., Живетеев К. В., Терентьев А. В. Исследование влияния подсветок в видимом диапазоне на сопротивление, терагерцовое поглощение кристаллов $ZnSe:Fe^{2+}$ и время жизни верхнего лазерного уровня 5T2 иона Fe^{2+}	**17:15** **Аксенов М. С.,** Гилинский А. М., Чистохин И. Б., Дмитриев Д. В., Гуляев Д. В., Гензе И. Ю., Путято М. А., Петрушков М. О., Преображенский В. В. Планарные и меза лавинные фотодиоды на основе InP/InGaAs/InP и InGaAs/InAlAs/InP гетероструктур
17:30 **Лобанов Д. Н.,** Калинников М. А., Кудрявцев К. Е., Андреев Б. А., Юнин П. А., Новиков А. В., Красильник З. Ф. Структурные и оптические свойства слоев InGaN для нитридной оптоэлектроники красного диапазона	**17:30** Аксенов М. С., Дерябин А. С., Колесников А. В., Лошкарев И. Д., **Никифоров А. И.,** Соколов Л. В., Чистохин И. Б., Фрицлер К. Б. Ge/Si PIN фотодиоды на основе гетероструктур, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии

17:00–18:30

17:45

Голеницкий К. Ю., Гуткин Г. М., Аверкиев Н. С.

Генерация поверхностных волн на второй гармонике в анизотропных полупроводниках с центром инверсии

17:45

Крыжановская Н. В., Махов И. С., Фоминых Н. А., Образцова А. А., Федосов И. С., Иванов К. А., Пивоварова А. А., Ильинская Н. Д., Яблонский А. Н., Жуков А. Е.

Ширина линии генерации и относительный шум интенсивности высокодобротных дисковых микролазеров с InGaAs/GaAs квантовыми точками

18:00

Рожков С. А., Бакин В. В., Еремеев С. В., Русецкий В. С., Голяшов В. А., Кустов Д. А., Орехов Д. К., Шайблер Г. Э., Альперович В. Л., Терещенко О. Е.

Определение зонной структуры Na_2KSb: фотоэмиссионная спектроскопия и расчеты из первых принципов

18:00

Гридчин В. О., Шугабаев Т., Даутов А. М., Калиничев А. А., Резник Р. Р., Котляр К. П., Шаров В. А., Лендяшова В. В., Цырлин Г. Э.

Синтез и свойства нитевидных нанокристаллов GaN на темплейтах GaN/AlN/Si(111) для создания нанолазеров

18:15

Овешников Л. Н., Фельде А. А., Муратов А. В., Давыдов А. Б., Чернопицский М. А., Минаев И. И., Клековкин А. В., Кривобок В. С.

Учёт вырождения зон при количественном анализе гальваномагнитных свойств и оптических спектров в терагерцовой области подложек *p*-GaSb

18:15

Алексеев А. Н., Алексеев В. А., Гердт А. Д., Карлин М. В., Новиков С. А., **Петров С. И.**, Литвинов М. А.

Реализация разработки производственно-ориентированного отечественного эпитаксиального и планарного оборудования для материалов A3B5

18:30–20:00

Стендовая сессия 2

- **Объемные полупроводники, перовскиты, органические полупроводники**
- **2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки**
- **0D системы**
- **Спин-зависимые явления**
- **Примеси и дефекты**
- **Топология в полупроводниках**

7 октября, среда

9:30—11:10

2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки 5

Председатель — С. А. Тарасенко

9:30 **Погосов А. Г.,** Сарыпов Д. И., Похабов Д. А., Жданов Е. Ю., Шевырин А. А., Бакаров А. К.

Электронный клапан Теслы

9:55 **Волков В. А.**

Размерное квантование геликонов в 2D электронных системах

10:10 **Похабов Д. А.,** Егоров Д. А., Жданов Е. Ю., Шевырин А. А., Бакаров А. К., Погосов А. Г.

Транспортное детектирование гидродинамических электронных вихрей

10:25 **Сарыпов Д. И.,** Похабов Д. А., Погосов А. Г., Жданов Е. Ю., Шевырин А. А., Бакаров А. К., Шкляев А. А.

Вязкое течение электронов с большим проскальзыванием в GaAs микросужениях

Спин-зависимые явления

Председатель — В. Д. Кулаковский

9:30 **Зюзин В. А.,** Голубинский В. П.

Аномальный эффект Холла в коллинеарных металлических антиферромагнетиках

9:55 **Рыжов И. И.,** Козлов В. О., Смирнов И. А., Запасский В. С., Козлов Г. Г.

Спектроскопия спиновых флуктуаций классических и новых полупроводниковых структур

10:20 **Давыдов М. Н.,** Джиоев Р. И., Кавокин К. В., Намозов Б. Р., Кусраев Ю. Г.

Исследование оптического охлаждения ядерной спиновой системы по поперечной компоненте спиновой ориентации электронов в эффекте Ханле

9:30—11:15

10:40 **Егоров Д. А.,** Похабов Д. А., Жданов Е. Ю., Шевырин А. А., Бакаров А. К., Погосов А. Г.

Измерение температурных зависимостей длины *e-e* рассеяния и релаксации импульса методом магнитной фокусировки

10:55 **Дорожкин С. И.,** Капустин А. А.

Гигантское перераспределение электронов в широкой квантовой яме в квантовом пределе по магнитному полю

10:35 **Шамирзаев Т. С.,** Смирнов Д. С., Кузнецова М. С., Колобкова Е. В., Майдебура Я. Е., Коптева Н. Е., Яковлев Д. Р., Bayer M.

Управление обменным взаимодействием в полупроводниковых наноструктурах

10:50 Николаев Г. А., Орлов О. В., Андреева С. А., Федотова Я. В., Хисамеева А. Р., **Щепетильников А. В.,** Юрасов Д. В., Новиков А. В., Кукушкин И. В.

Электрическое детектирование спинового резонанса с разрешением по времени

11:15—11:30

11:15 **Кофе-брейк**

Зал А

11:30—13:30

Мемориальная сессия памяти Роберта Арнольдовича Суриса

Председатель — М. М. Глазов

11:30 **Хабибуллин Р. А.,** Иконников А. В., Пономарев Д. С., Афоненко А. А., Ушаков Д. В.

Непрерывные квантово-каскадные лазеры терагерцового диапазона

12:00 **Гавриленко В. И.**

Терагерцовые квантовые каскадные лазеры в квантующих магнитных полях

11:30—13:30

12:30

Дюделев В. В., Андреев А. Д., Чистяков Д. В., Подопригора В. В., Никитин А. А., Михайлов Д. А., Черотченко Е. Д., Врубель И. И., Мыльников В. Ю., Лосев С. Н., Дерягин Н. Г., Абдулразак С. Х., Бабичев А. В., Лютецкий А. В., Слипченко С. О., Пихтин Н. А., Гладышев А. Г., Подгаецкий К. А., Андреев А. Ю., Яроцкая И. В., Ладугин М. А., Мармалюк А. А., Папылев Д. С., Новиков И. И., Когновицкая Е. А., Дерягин А. Г., Кучинский В. И., Карачинский Л. Я., Егоров А. Ю., Соколовский Г. С.

Квантово-каскадные детекторы для длинноволнового инфракрасного диапазона

12:45

Бурдов В. А., Фомичев С. А

Связанные экситон-биэкситонные состояния в полупроводниковых нанокристаллах: тонкая структура спектра, времена генерации

13:00

Родина А. В., Головатенко А. А., Бельтюков Я. М, Алексеев А. Ю

Влияние диэлектрического контраста на энергетический спектр и волновые функции электрона в наноструктурах

13:15

Семина М. А., Глазов М. М.

Спин-долинная релаксация ридберговских экситонов в атомарно-тонких полупроводниках

13:35—15:00

13:35

Обед

15:30—20:00

15:30

Экскурсия

Музей «Атом» на ВДНХ

Отъезд автобусов от ФИАН в 14:30

8 октября, четверг

	Зал А	Зал Б
9:30—11:15	**Фотонные кристаллы, метаматериалы, нанофотоника, оптомеханика 2** *Председатель — П. И. Арсеев*	**Топология в полупроводниках 2** *Председатель — Д. Р. Хохлов*
	9:30 **Серов Ю. М.,** Галимов А. И., Сорокин С. В., Малеев Н. А., Кулагина М. М., Задиранов Ю. М., Климко Г. В., Рахлин М. В., Веретенников А. И., Вейшторт Г. П., Лакунцова О. Е., Салий Ю. А., Березина Д. С., Трошков С. И., Васильев А. П., Кузьменков А. Г., Бобров М. А., Седова И. В., Шубина Т. В., Торопов А. А. Новый дизайн источника одиночных фотонов телекоммуникационного диапазона: рекорд эффективности и анализ параметров	**9:30** **Девятов Э. В.** Топологические поверхностные состояния для альтермагнетиков
	9:55 **Морозов С. В.,** Уточкин В. В., Разова А. А., Фадеев М. А., Румянцев В. В., Мажукина К. А., Янцер А. А., Шенгуров Д. В., Морозова Е. Е., Гусев Н. С., Барышев В. В., Гинзбург Н. С., Егорова Е. Д., Михайлов Н. Н., Дубинов А. А., Алешкин В. Я., Соколовский Г. С., Дюделев В. В., Егоров А. Ю., Гавриленко В. И. РОС-лазер с вертикальным выводом излучения на основе структуре КЯ HgCdTe с брэгговской решеткой третьего порядка	**9:55** **Шикин А. М.,** Макеев Р. В., Ерыженков А. В., Тарасов А. В. Вейлевские полуметаллы и полуметаллы с замкнутой нодальной линией в системах на основе магнитного топологического изолятора $MnBi_2Te_4$
	10:20 **Крайнов И. В.,** Галимов А. И., Рахлин М. В., Шубина Т. В., Торопов А. А. Механизмы резонансного рассеяния и переизлучения фотонов в двухуровневой системе при импульсном возбуждении	**10:20** **Русинов И. П.,** Меньшов В. Н., Чулков Е. В. Топологические изоляторы с антиферромагнитным упорядочением

9:30—11:15	**10:35** **Новиков А. В.,** Захаров В. Е., Яблонский А. Н., Юрасов Д. В., Шалеев М. В., Демидов Е. В., Вербус В. А., Шенгуров Д. В., Морозова Е. Е., Михайлов А. Н., Тетельбаум Д. И., Краев С. А., Родякина Е. Е. Светодиоды с Ge(Si) наноостровками для Si фотоники с выводом излучения в планарный волновод или в свободное пространство	**10:45** **Максимов А. А.,** Тартаковский И. И., Абдуллаев Н. А., Мамедов Н. Т. Низкотемпературные исследования комбинационного рассеяния света в магнитных топологических изоляторах
	10:50 **Шаров В. А.,** Шугабаев Т. М., Лендяшова В. В., Новикова К. Н., Мухин И. С., Цырлин Г. Э., Гридчин В. О. Измерение электролюминесценции одиночных непланарных наноструктур	**11:00** **Степина Н. П.,** Баженов А. О., Коптев Е. С., Шумилин А. В., Ненашев А. В., Жданов Е. Ю., Ищенко Д. В., Голяшов В. А., Терещенко О. Е., Аксенов М. С., Кириенко В. В. Электронный транспорт в пленках магнитных топологических изоляторов $MnBi_2Te_4$, выращенных с помощью МЛЭ
11:15—11:30	**11:15** **Кофе-брейк**	

11:30—13:25

Примеси и дефекты 2

Председатель — Д. В. Гуляев

11:30 **Лебедев А. А.,** Бауман Д. А., Давыдовская К. С., Козловский В. В., Левинштейн М. Е., Николаев А. Е., Стрельчук А. М.

Особенности радиационной стойкости широкозонных полупроводников SiC, GaN, Ga_2O_3

11:55 **Гудков В. В.**

Физическая акустика ян-теллеровских примесей в полупроводниках

12:20 **Осинных И. В.,** Малин Т. В., Милахин Д. С., Александров И. А., Протасов Д. Ю.

Оптические и электрические свойства структур GaN:Mg, выращенных методом аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии

12:35 **Аверкиев Н. С.,** Рожанский И. В., Третьяков Р. Е..

Обменное рассеяние на нейтральных примесях в полупроводниках

12:50 **Скоморохов А. М.,** Гурин А. С., Крамущенко Д. Д., Баранов П. Г., Бабунц Р. А.

Оптическая регистрация кросс-релаксации примесных центров в алмазе

Атомарно-тонкие полупроводники, наномеханика

Председатель — Л. В. Кулик

11:30 **Кунцевич А. Ю.,** Клоков А. Ю., Иевлева В. А., Пугачев М. В., Фролов Н. Ю., Шарков А. И.

Межслоевая связь в ван-дер ваальсовых гетероструктурах: жесткость, прочность, трение, управление

11:55 **Манцевич В. Н.,** Кривенко И. С., Смирнов Д. С.

Хиральный магнетизм в монослоях дихалькогенидов переходных металлов

12:20 **Покровский В. Я.,** Васильев Д. М., Никитин М. В., Мартовицкий В. П., Васильев А. Л., Трунькин И. Н., Зыбцев С. Г.

Структура образцов NbS_3, претерпевших спинодальный распад, и протекание в них тока волны зарядовой плотности

12:35 **Шевырин А. А.,** Бакаров А. К., Погосов А. Г.

Наномеханическое детектирование электронных вихрей

12:50 **Еналдиев В. В.,** Алисултанов З. З.

Резонансные поглощение и фотогальванический эффект в твистронных сегнетоэлектрических гетероструктурах

11:30—13:25	**13:05** **Соломникова А. В.,** Савченко Г. С., Зубков В. И., Аверкиев Н. С. Ключевые аспекты диагностики монокристаллического алмаза с примесью бора в неравновесном и квазиравновесном режимах	**13:05** **Алексеев П. А.,** Попов М. Е., Гасникова К. А., Елисеев И. А., Кравцов В., Давыдов В. Ю. Микродисковые светоизлучающие гетероструктуры $SnS_2/WS_2/SnS_2$
	13:20 Лактаев И. Д., Горкин Д. Н., Свяховский С. Е., Гварамия А. Г., Дорофеев С. Г., **Смирнов А. М.** Особенности фотолюминесценции нанотетраподов CdSe:Cu при взаимодействии с фотонными кристаллами	**13:20** **Яковлев З. А.,** Глазов М. М. Теория экситон-магнонного взаимодействия и взаимного увлечения в слоистом антиферромагнетике CrSBr
13:35—15:00	**13:35** **Обед**	

Зал А

15:00—17:00	**Мемориальная сессия памяти Владислава Борисовича Тимофеева** *Председатель — Д. Р. Яковлев*
	15:00 **Горбунов А. В.,** Кулик Л. В. Фазовая диаграмма магнитоэкситонного конденсата

15:00–17:00

15:30

Деменев А. А., Гиппиус Н. А., **Кулаковский В. Д.**

Динамика локализованных спинорных экситон-поляритонных конденсатов в двойных потенциальных ловушках в GaAs/AlAs микрорезонаторе при резонансном пикосекундном возбуждении

16:00

Гиппиус Н. А, Фрадкин И. М., Салахова Н. С., Дьяков С. А.

Метод резонансного подпространства для составных фотонно-кристаллических систем

16:30

Черненко А. В., Бричкин А. С., Голышков Г. М., Бисти В. Е.

Взаимодействие экситонов со свободными носителями заряда в монослоях ДПМ

16:45

Кулик Л. В., Ларионов А. В.

Неупругое рассеяние света на возбуждениях лафлиновской жидкости

17:00–17:30

17:00 **Выступления спонсоров**

17:30–18:30

17:30 **Экскурсии по ФИАН**

18:30–21:00

18:30 **Банкет**

9 октября, пятница

Зал А

10:00—11:15

Спин-зависимые явления

Председатель — А. А. Гиппиус

10:00 **Будкин Г. В.**

Эффект увлечения спина фотонами в двумерных структурах

10:15 **Кустов Д. А.,** Русецкий В. С., Рожков С. А., Бакин В. В., Шайблер Г. Э., Шамирзаев Т. С., Голяшов В. А., Альперович В. Л., Терещенко О. Е.

Исследование вклада поверхностных состояний в фотоэмиссию спин-поляризованных электронов из механически напряжённых $Na_2KSb(Cs,Sb)$ фотокатодов

10:30 **Кокурин И. А.,** Аверкиев Н. С.

Ферромагнетизм в (Ga,Mn)As: новый взгляд на проблему

10:45 **Пошакинский А. В.**

Долгоживущие спиновые текстуры в двумерных сетках

11:00 **Козырев Н. В.,** Жуков Е. А., Намозов Б. Р., Яковлев Д. Р., Седова И. В., Сорокин С. В., Кусраев Ю. Г.

Ангармонизм осцилляций в эффекте Керра, вызванных ларморовой прецессией намагниченности ионов марганца в квантовых ямах и квантовых точках $(A^{II},Mn)B^{VI}$

11:15—11:30

11:15 **Кофе-брейк**

11:00–12:40	**Полупроводниковые приборы и устройства 2** *Председатель — Ф. А. Пудонин*
	11:30 **Гуляев Д. В.,** Дмитриев Д. В., Гилинский А. М., Аксенов М. С., Царев А. В., Колосовский Е. А. Электронная компонентная база волоконно-оптических линий связи и радиофотоники на основе InGaAs/InAlAs/InP структур
	11:55 **Виноградов С. Л.** Исследования и разработки кремниевых фотоумножителей
	12:10 **Пономарев Д. С.,** Галиев Р. Р., Гарабов Д. В., Павлов А. Ю., Хабибуллин Р. А., Борисов Ю. И., Зайцев К. И., Лаврухин Д. В. Оптоэлектронный трансивер для импульсной терагерцовой спектроскопии
	12:25 **Новиков А. В.,** Шалеев М. В., Юрасов Д. В., Шмырин Д. А., Ревин Л. С., Демидов Е. В., Панкратов А. Л., Храпай В. С., Тихонов Е. С., Антонов А. В., Дроздов М. Н., Красильникова Л. В., Ежевский А. А., Ситников С. В., Щеглов Д. В., Красильник З. Ф. SiGe гетероструктуры для «электронных» и «дырочных» кубитов
12:40–13:20	**Пленарное заседание 2** *Председатель — А. А. Горбацевич*
	12:40 Суетин Николай Владиславович Искусственный интеллект в науке: инструменты, подходы и трансформация исследовательских практик
13:30–14:30	**13:30** **Закрытие конференции**

Стендовая сессия 1 (понедельник)

Поверхность, пленки, слои

П1

Щемеров И. В., Поляков А. Я., Васильев А. А., **Алексанян Л. А.,** Николаев В. И., Шапенков С. В., Тимашов Р. А., Шишкова Ю. Е., Темиров А. С., Гузилова Л. И.

Рост слоев оксида галлия на подложке SiC для уменьшения теплового сопротивления

П2

Балакирев С. В., Солодовник Н. Е., Шандыба Н. А., Кириченко Д. В., Духан Д. Д., **Ерёменко М. М.,** Солодовник М. С.

Упорядоченные массивы квантовых точек InAs на структурированных поверхностях GaAs (001) и (111)

П3

Баранов А. И., Будаговский И. А., Эль-Хадж Л. А., Терехов Д. Ю., Лазаренко П. И., Смаев М. П.

Роль теплопроводности подложки в кристаллизации тонких аморфных пленок $Ge_2Sb_2Te_5$ векторным лазерным пучком

П4

Баранов А. И., Уваров А. В., Вячеславова Е. А., Максимова А. А., Михайлов О. П., Поздеев В. А., Ярчук Э. Я., Гудовских А. С.

Исследование пассивирующих свойств различных оксидов (Al_2O_3, Ga_2O_3, TiO_2, MoO) на развитой поверхности кремния

П5

Вакулов З. Е., Богуш И. Ю., Томинов Р. В., Паршина Н. В., Смирнов В. А.

Формирование пленок титаната бария при различном давлении кислорода для нейроморфных применений

П6

Волкова Л. С., Гришин Т. С., Латипов Е. В., Дудин А. А., Дубков С. В., Назаркина Ю. В., Громов Д. Г., Гаврилов С. А.

Влияние термообработки на структурное состояние и оптические свойства массивов наностолбиков TiO_2

П7

Гагарина А. Ю., Спивак Ю. М., Козодаев Д. А.

Развитие возможностей качественной диагностики кислотных и основных центров Льюиса и Брёнстеда на поверхности твердых тел методами атомно-силовой микроскопии

П8

Галиуллин А. А., Матиенко Д. А., Бажанов К. А., Кунцевич А. Ю.

Электрофизические и теплофизические свойства полимерных композитов с графеновыми нанопластинами

Поверхность, пленки, слои

П9 **Гагис Г. С.,** Гордеева А. Б., Нельсон Д. К., Гущина Е. В., Калюжный Н. А., Салий Р. А., Щеглов М. П., Васильев В. И.

Твердофазное изовалентное замещение элементов V группы в пластинах InP и GaAs с полуизолирующими свойствами

П10 **Гришин Т. С.,** Волкова Л. С., Дудин А. А., Дубков С. В., Громов Д. Г., Гаврилов С. А.

Материал-специфические особенности морфологической эволюции массивов наночастиц Au и Ag при низкотемпературном отжиге

П11 **Жилицкий В. Е.,** Антонов В. А., Смагина Ж. В., Спесивцев Е. В., Попов В. П.

Импеданс-спектроскопия псевдо-КНИ структур с высокоомными скрытыми TR-HR слоями в низкоомном кремнии

П12 **Зиновьева А. Ф.,** Зиновьев В. А., Кацюба А. В., Володин В. А., Лошкарев И. Д., Спесивцев Е. В., Двуреченский А. В.

Синтез однородного массива нанокристаллов $CaSi_2$, встроенных в слой CaF_2 на подложке Si (111)

П13 **Ивченко В. С.,** Казанцев Д. В., Казанцева Е. А., Матиенко Д. А., Кунцевич А. Ю.

Распространение поверхностных фонон-поляритонов в полярном кристалле SiC в присутствии h-BN

П14 **Измайлов Р. И.,** Кобцев Д. М., Зеленский Г. В., Гайдученко И. А., Ковалюк В. В., Дашевский З. М., Гольцман Г. Н.

Разработка и формирование вертикального *p*–*n*-перехода в нанокристаллических плёнках PbTe

П15 **Кондратов М. И.,** Шамахов В. В., Слипченко С. О., Гришин А. Е., Николаев Д. Н. Пихтин Н. А.

Формирование слоёв GaAs на подложке Si методом селективной эпитаксии

П16 **Манцуров Н. Д.,** Мутилин С. В, Комонов А. И., Волошин Б. В., Кичай В. Н., Яковкина Л. В., Селезнев В. А.

Кинетика кристаллообразования диоксида ванадия при отжигах упорядоченных массивов одиночных аморфных наноостровков

П17 **Пестовский Н. В.,** Савинов С. Ю.

Передача энергии частицам окружающего газа от приповерхностных электронных возбуждений широкозонных материалов

Поверхность, пленки, слои

П18

Резник Р. Р., Андреева А. С., Даутов А. М., Котляр К. П., Илькив И. В., Хребтов А. И., Panciera F., Дубровский В. Г., Цырлин Г. Э.

Формирование золотых капель в упорядоченных отверстиях в слое SiO_x на поверхности кремния для последующего селективного синтеза III-V нитевидных нанокристаллов

П19

Казанцев Д. М., Бакин В. В., **Рожков С. А.,** Шайблер Г. Э., Альперович В. Л., Терещенко О. Е.

Тонкая структура в энергетических распределениях электронов, эмитированных из полупроводников с отрицательным электронным сродством: моделирование Монте-Карло

П20

Седова И. В., Львова Т. В., Сорокин С. В., Дементьев П. А., Климко Г. В., Лебедев М. В.

Исследование процесса окисления распределённых брэгговских отражателей $GaAs/Al_{0.9}Ga_{0.1}As$

П21

Духан Д. Д., Балакирев С. В., **Кугаевский А. Д.,** Солодовник Н. Е., Махов И. С., Еременко М. М., Кириченко Д. В., Шандыба Н. А., Крыжановская Н. В., Солодовник М. С.

Исследование процессов формирования КТ InAs/GaAs на структурированных методом капельного травления поверхностях

П22

Солодовник Н. Е., Кириченко Д. В., Шандыба Н. А., Балакирев С. В., Солодовник М. С.

Механизмы локального квазикапельного травления GaAs в точках воздействия фокусированным ионным пучком

П23

Чарикова Т. Б., Павлова А. Ю., Попов М. Р., Поздин А. В., Смольников М. И., Маскаева Л. Н.

Взаимосвязь электрических свойств и фотоэлектрических параметров в пленках сульфида свинца, легированных галогенами

П24

Шульман А.Я.

К вопросу о «пиннинге» уровня Ферми в полупроводниках

П25

Шульман А.Я.

Уравнение эффективной массы в двухзонной модели Кэйна и метод огибающих функций

П26

Шуплецов А. В., Банников М. И., Прудкогляд В. А., Литун Я. Б., Бочаров А. Ю., Кунцевич А. Ю.

Магнитосопротивление и эффект Холла в многослойном CVD графене

ВЧ явления в полупроводниках

П27 **Андреев И. В.,** Муравьев В. М., Кукушкин И. В.

Поперечные плазмон-поляритоны в поглощении двумерных электронных систем на диэлектрических подложках

П28 **Андронов А. А.,** Позднякова В. И.

Интерпретация перехода в электрическом поле резонансного ТГц отражения от поглощения к усилению в сэндвичах с графеном и перспективы создания универсального ТГц лазера на сэндвичах

П29 **Ляшенко А. А.,** Ормонт М. А.

Отклонение высокочастотной проводимости кремния с водородоподобной примесью от универсальности

П30 **Попов В. Г.,** Самарин С. С.

Генератор импульсов на основе ультракоротких лазерных импульсов

П31 Хабибуллин Р. А., **Пушкарёв С. С.,** Иконников А. В., Белов Д. А., Глинский И. А.

Управление межмодовым интервалом ТГц квантово-каскадного лазера путём инжекции СВЧ-сигнала в тракт питания лазера

П32 **Шинко И. С.,** Муравьев В. М., Андреев И. В., Заболотных А. А., Казаков А. С., Кукушкин И. В.

Уширение плазменного резонанса в магнитном поле в двумерной электронной системе

Атомарно-тонкие полупроводники

П33 **Глазов М. М.**

Экситонный изолятор в гетероструктурах на основе дихалькогенидов переходных металлов

П34 **Глазов М. М.,** Шенцев А. М., Григорян К. К.

Терагерцовые переходы в ван-дер-ваальсовых гетероструктурах

П35 Бисти В. Е., **Голышков Г. М.,** Бричкин А. С, Черненко А. В.

Внутрислоевое и межслоевое взаимодействие в муаровой сверхрешетке гетеробислоя $MoSe_2/WSe_2$

П36 **Голышков Г. М.,** Бричкин А. С., Бисти В. Е., Черненко А. В.

Влияние муара на внутрислоевые и межслоевые экситоны в гетеробислое $MoSe_2/WSe_2$

Атомарно-тонкие полупроводники, наномеханика

П37 **Гуськов А. А.,** Лавров С. Д., Венглинская С. А.

Численное моделирование динамики фототока в фототранзисторах на основе монослойного MoS_2

П38 **Дурнев М. В.,** Смирнов Д. С.

Линейная поляризация интерфейсных экситонов на латеральных гетеропереходах

П39 **Загороднев И. В.,** Понкратова Д. В., Еналдиев В. В.

Спонтанное упорядочение дипольных моментов в монослоях висмута с орторомбической структурой

П40 **Кочиев М. В.,** Каменская Т. А., Кунцевич А. Ю.

Оптические свойства закрученных двумерных материалов

П41 Никитин М. В., Покровский В. Я., **Салтыкова Д. Ю.,** Колесов В. В., Кашин В. В., Кузнецова И. Е., Недоспасов И. А.

Динамика волны зарядовой плотности при пространственно-неоднородном акустическом воздействии

П42 **Салтыкова Д. Ю.,** Никитин М. В., Покровский В. Я., Зыбцев С. Г.

Влияние механических колебаний на проводимость волны зарядовой плотности в $(TaSe_4)2I$

Фотонные кристаллы, метаматериалы

П43 **Горелкина Т. Д.,** Калантаевский И. Э., Кравцов В. А.

Управление распространением экситон поляритонов в CrSBr

П44 **Дмитриева О. А.,** Тиходеев С. Г.

Нелинейный отклик полупроводникового микрорезонатора с экситонными слоями

П45 Смагина Ж. В., Зиновьев В. А., Зиновьева А. Ф., Федина Л. И., Гутаковский А. К., Вдовин В. И., Яблонский А. Н., **Захаров В. Е.,** Мудрый А. В., Живулько В. Д., Двуреченский А. В.

Структура и оптические свойства кластеров точечных дефектов, введенных в кремний облучением ионами Ge^+

П46 **Казаков А. С.,** Шинко И. С., Андреев И. В., Муравьев В. М., Кукушкин И. В.

Перестраиваемый метаматериал на основе двумерной электронной системы в геометрии разрезного кольцевого резонатора

Фотонные кристаллы, метаматериалы, нанофотоника, оптомеханика

П47 **Кириенко В. В.,** Якимов А. И., Уткин Д. Е., Двуреченский А. В.

Усиление фототока в Ge/Si фотодиодах с квантовыми точками, содержащих двумерные решетки микроотверстий различной глубины

П48 **Коротченков А. В.,** Аверкиев Н. С.

Оптическая анизотропия решётки металлических наночастиц

П49 **Крафтмахер Г. А.,** Бутылкин В. С., Каленов Д. С., Фишер П. С.

Оптическое и магнитооптическое управление распространением микроволн при взаимодействии с киральными мета-средами и мета-диполями

П50 **Кукенов О. И.,** Лозовой К. А., Дирко В. В., Майер К., Ворсин О., Смородин К., Катренко В., Шабанов Г., Коханенко А. П.

Управление свойствами эпитаксиальных Ми-резонаторов GeSi, получаемых послеростовым отжигом в камере эпитаксии

П51 **Маликов Р. О.,** Дьяков С. А., Тиходеев С. Г.

Максимально хиральный терагерцовый отклик моноклинной кремниевой метамембраны

П52 **Милёхин И. А.,** Шербакова Д. А., Тумашев В. С., Кузнецов С. А., Родякина Е. Е., Дуда Т. А., Милёхин А. Г., Латышев А. В.

Повышение чувствительности поверхностно усиленной инфракрасной спектроскопии с помощью планарных массивов золотых наноантенн, заглублённых методом каталитического травления

П53 Зиновьев В. А., Зиновьева А. Ф., Смагина Ж. В., Кацюба А. В., Родякина Е. Е., Степихова М. В., Шаров С. А., Шенгуров Д. В., **Новиков А. В.**

Резонансные фотонные состояния в одиночных Si микродисках со встроенными GeSi квантовыми точками

П54 Степихова М. В., Чуприн И. А., Беспалов А. А., Смолина Е. О., **Перетокин А. В.,** Шалеев М. В., Родякина Е. Е., Шенгуров Д. В., Новиков А. В.

Возможности локализации излучения в топологических дефектах типа замкнутых границ зерен в фотонных кристаллах

П55 **Трушин О. С.,** Фаттахов И. С., Чебохин М. М., Попов А. А., Мазалецкий Л. А., Федоров А. С., Логунов М. В.

Киральный оптический отклик кремниевых наноспиралей, полученных методом наклонного напыления

Полупроводниковые приборы и устройства

П56 **Абрамкин Д. С.,** Буров А. С., Мансуров В. Г., Малин Т. В., Милахин Д. С.

Новый AlGaN/AlN транзистор с покровным слоем AlGaN переменного состава

П57 **Белов Д. А.,** Иконников А. В., Ушаков Д. В., Афоненко А. А., Жмудь Б. А., Галиев Р. Р., Павлов А. Ю., Хабибуллин Р. А.

Двухсекционный терагерцовый квантово-каскадный лазер с двойным металлическим волноводом

П58 **Бобров М. А.,** Ковач Я. Н., Блохин А. А., Кузьменкова Н. А., Марчий М. Н., Кузьменков А. Г., Пазгалев А. С., Васильев А. П., Малеев Н. А., Блохин С. А.

Поляризационные шумы вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 89х нм гибридной конструкции

П59 **Гензе И. Ю.,** Аксенов М. С., Чистохин И. Б., Гилинский А. М., Дмитриев Д. В., Гуляев Д. В., Закиров Е. Р., Вдовин В. И., Гутаковский А. К.

Механизм изменения параметров границ раздела металл/InAlAs при температурном воздействии

П60 Войцеховский А. В., Дзядух С. М., **Горн Д. И.,** Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н., Сидоров Г. Ю., Якушев М. В.

Фотоэлектрические характеристики MWIR nBn-структур на основе HgCdTe со сверхрешёточным барьером

П61 **Гришин А. Е.,** Шамахов В. В., Кондратов М. И., Слипченко С. О., Пихтин Н. А.

Исследование дизайна активной области лазерной гетероструктуры на основе множественных напряженных квантовых ям

П62 **Дашков А. С.,** Хахулин С. А., Костромин Н. А., Комков О. С., Пирогов Е. В., Соболев М. С., Горай Л. И., Буравлев А. Д.

Комплексный экспериментально-теоретический подход к исследованию источников и детекторов ИК и ТГц диапазонов

П63 **Елисеев И. А.,** Осоченко Г. В., Kurtash V. A., Давыдов В. Ю.

Связь особенностей спектров КРС и ФЛ с характеристиками сегнетоэлектрических фототранзисторов на основе α-In_2Se_3

П64 **Ерошенко Г. Н.,** Кривобок В. С., Минаев И. И., Савин К. А., Клековкин А. В., Дубовая А. Р., Николаев С. Н.

Оптические свойства полупроводниковых сверхрешеток на основе узкозонных полупроводников A3B5

Полупроводниковые приборы и устройства

П65 **Жидяев К. С.,** Чигинева А. Б., Байдусь Н. В., Самарцев И. В.

Низковольтные быстродействующие тиристоры на основе структуры GaAs/AlGaAs

П66 **Ковалюк В. В.,** Кобцев Д. М., Гайдученко И. А., Измайлов Р. И., Дашевский З. М., Гольцман Г. Н.

Поликристаллические пленки $Pb_{1-x}Sn_xTe$:In на гибкой подложке: от структурных свойств к *p–n*-переходам и ИК-фотодетекторам

П67 **Копчинский И. Д.,** Шорохов В. В., Попов А. А., Шагалов Н. А.

Квантовая ёмкость двойной наведённой квантовой точки в нанопроводе — модель спинового кубита КНИ

П68 Стрельчук А. М., Козловский В. В., **Лебедев А. А.**

Влияние облучения электронами высокой дозой и последующего отжига на вольт-амперные характеристики диодов Шоттки на основе карбида кремния

П69 **Литовский Л. Я.,** Васильевский И. С., Виниченко А. Н., Бурдыкин М. С., Кытин В. Г.

Терморезистивные свойства тонкоплёночных структур NbN_x, полученных методом реактивного магнетронного напыления

П70 **Михайлов Д. А.,** Дюделев В. В., Чистяков Д. В., Черотченко Е. Д., Врубель И. И., Лосев С. Н., Мыльников В. Ю., Дерягин Н. Г., Дерягин А. Г., Абдулразак С. Х., Бабичев А. В., Лютецкий А. В., Слипченко С. О., Пихтин Н. А., Гладышев А. Г., Подгаецкий К. А., Андреев А. Ю., Яроцкая И. В., Ладугин М. А., Мармалюк А. А., Папылев Д. С., Новиков И. И., Когновицкая Е. А., Кучинский В. И., Карачинский Л. Я., Егоров А. Ю., Соколовский Г. С.

Определение концентрации метана с помощью перестраиваемого квантово-каскадного лазера среднего инфракрасного диапазона

П71 **Михайлов П. О.,** Шорохов В. В., Трифонов А. С.

Управление состояниями кубитов на основе наведенных квантовых точек в кремнии

П72 **Петякин Н. В.,** Иванов А. И., Антонова И. В.

Графеновые частицы, синтезированные из терморасширенного графита, для гибкой печатной электроники

П73 **Ризаев А. Э.,** Гришин А. Е., Кондратов М. И., Шушканов И. В., Подоскин А. А., Слипченко С. О., Пихтин Н. А.

Эффект продольного пространственного выжигания носителей заряда в мощных полупроводниковых лазерах InGaAsP/InP с длиной волны 1.55 мкм

Полупроводниковые приборы и устройства

П74 **Сагитова А. С.,** Волков С. Д., Богданова А. П., Кривецкий В. В.

Газовая чувствительность ультрадисперсного нанокристаллического $Fe_xGa_{2-x}O_3$ (x = 0.67; 1) со структурой β-Ga_2O_3

П75 **Самарцев И. В.,** Байдусь Н. В.

Фоточувствительные структуры на длину волны более 1 мкм, выращенные на подложках Si

П76 **Слипченко С. О.,** Шашкин И. С., Подоскин А. А., Шушканов И. В., Ризаев А. Э., Кондратов М. И., Гришин А. Е., Пихтин Н. А.

Квантоворазмерные гетероструктуры для модуляторов лазерного излучения с высоким коэффициентом экстинкции

П77 **Слипченко С. О.,** Подоскин А. А., Шушканов И. В., Ризаев А. Э., Кондратов М. И., Гришин А. Е., Багаев Т. А., Ладугин М. А., Мармалюк А. А., Симаков В. А., Пихтин Н. А.

Многопереходные гетероструктуры тиристорного типа для быстродействующих токовых ключей и импульсных источников лазерного излучения

П78 **Суханов М. А.,** Бакаров А. К., Лошкарев И. Д., Пономарев С. А., Гуляев Д. В.

ИК фотоприемники на основе InAlSb/InSb гетероструктур

П79 **Уточкин В. В.,** Паулкина Я. Н., Румянцев В. В., Фадеев М. А., Разова А. А., Мажукина К. А., Янцер А. А., Шенгуров Д. В., Краев С. А., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А., Морозов С. В.

Спектроскопия электролюминесценции в HgCdTe-структурах при латеральной токовой накачке

П80 **Черотченко Е. Д.,** Врубель И. И., Дюделев В. В., Андреев А. Д., Чистяков Д. В., Подопригора В. В., Никитин А. А., Михайлов Д. А., Мыльников В. Ю., Лосев С. Н., Дерягин Н. Н., Абдулразак С. Х., Бабичев А. В., Лютецкий А. В., Слипченко С. О., Пихтин Н. А., Гладышев А. Г., Подгаецкий К. А., Андреев А. Ю., Яроцкая И. В., Ладугин М. А., Мармалюк А. А., Папылев Д. С., Новиков И. И., Когновицкая Е. А., Кучинский В. И., Карачинский Л. Я., Егоров А. Ю., Соколовский Г. С.

Характеризация теплового рассеяния в ККЛ с помощью эффективной константы температуропроводности

П81 **Шушканов И. В.,** Ризаев А. Э., Гришин А. Е., Кондратов М. И., Подоскин А. А., Слипченко С. О., Пихтин Н. А.

К вопросу о выборе оптимальной конструкции полупроводникового лазера для работы в режиме модуляции усиления

Стендовая сессия 2 (вторник)

Объемные полупроводники, перовскиты, органические полупроводники

B1 **Алексеев П. А.,** Махмудпур А., Гасникова К. А., Фурасова А., Макаров С.

Наномемристор на основе галогенидного перовскита

B2 **Бажин П. С.,** Литвяк В. М., Кавокин К. В.

Определение ядерных локальных полей в GaAs:Mn при разной степени поляризации электронов

B3 **Булгаков К. А.,** Пахомова А. А., Грень Д. Д., Пежемский А. Н., Саранин Д. С.

Повышение прозрачности перовскитных ячеек во VNIR диапазоне для тандемных ФЭП с гетероструктурным кремнием

B4 **Воронов В. А.,** Саранин Д. С.

Применение покрытий ДМД в качестве полупрозрачных электродов для ПСЭ

B5 **Галеева А. В.,** Чмырь С. Н., Артамкин А. И., Долженко Д. Е., Чернов М. Ю., Хохлов Д. Р.

Микроволновая фотопроводимость в условиях слабой локализации в гетероструктурах на основе $Al_xGa_{1-x}As$:Si

B6 **Гордеева А. Б.,** Макаренко И. В., Нащёкин А. В., Гущина Е. В., Теруков Е. И.

Влияние свойств поверхности подложки на рост кристаллитов фталоцианина меди CuPc

B7 Гагис Г. С., **Гордеева А. Б.,** Нельсон Д. К., Гущина Е. В., Калюжный Н. А., Салий Р. А., Щеглов М. П., Васильев В. И.

Твердофазное изовалентное замещение элементов V группы в пластинах InP и GaAs с полуизолирующими свойствами

B8 **Грень Д. Д.,** Пежемский А. Н., Сергеев О. С., Рябцева М. В., Саранин Д. С.

Перовскитные солнечные модули на радиационностойких подложках для применения в космосе

B9 Таврунова Н. Ю., Сарычев М. Н., **Жевстовских И. В.,** Коростелин Ю. В., Аверкиев Н. С., Гудков В. В.

Динамические и статические свойства ян-теллеровской подсистемы в кристалле ZnTe:Cr

Объемные полупроводники, перовскиты, органические полупроводники

B10 **Литвиненко Д. Н.,** Никитенко В. Р.

Разделение геминальной пары в органических полупроводниках: моделирование методом Монте-Карло

B11 **Мыза А. С.,** Завертяев М. В., Загуменный А. И., Козлов В. А., Пестовский Н. В., Савинов С. Ю., Цхай В. С.

Люминесцентные и оптические характеристики кристалла Lu_2SiO_5:Ce, выращенного в атмосфере молекул N_2

B12 **Пахомова А. А.,** Булгаков К. А., Дорофеев Д. Ю., Саранин Д. С.

Модификация широкозонного перовскита для интеграции в высокоэффективные тандемные структуры с кремнием

B13 **Сарычев М. Н.,** Жевстовских И. В., Жерлицын С. В., Коростелин Ю. В., Аверкиев Н. С. Гудков В. В.

Влияние пьезоэлектричества на ян-теллеровский вклад в поглощение ультразвуковых волн в кристалле CdSe:Cr

B14 **Сарычев М. Н.,** Жевстовских И. В., Ахатов М. В, Семенова О. И.

Объёмная и приповерхностная рекомбинация носителей заряда в гибридном перовските $CH_3NH_3PbBr_3$

B15 **Сегаль Г. В.,** Воронов В. А., Хейфец С. С., Феклистова А. А., Сергеев О. С., Бадурин И. В., Гостищев П. А., Саранин Д. С.

Масштабирование перовскитных солнечных модулей

B16 **Семенова Л. Е.**

Анализ резонансного рассеяния света на LO фононах при двухфотонном возбуждении в кристалле сульфида кадмия

B17 **Семенова Л. Е.**

Резонансное рассеяние света на 2LO фононах при двухфотонном возбуждении в кристалле CdS

B18 **Таланов М. В.,** Троценко Е. Г., Авакян Л. А., Горшунов Б. П.

Симметрийный подход к управлению шириной запрещённой зоны в галогенидных перовскитах

Объемные полупроводники

B19 Николаев С. Н., Кривобок В. С., **Усманов И. И.,** Екимов Е. А.

Исследование кинетики люминесценции слоистого соединения SnS_2:Tm, синтезированного при высоком давлении

B20 **Черемных Н. А.,** Ситников М. Н., Харьков А. М., Аплеснин С. С.

ФотоЭДС в твёрдых растворах системы $MnZn_{1-x}CrSb$

B21 **Чмырь С. Н.,** Галеева А. В., Долженко Д. Е., Артамкин А. И., Чернов М. Ю., Хохлов Д. Р.

Шубниковские осцилляции отрицательного магнитосопротивления и микроволновой фотопроводимости в GaAs:Si

2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки

B22 **Алисултанов З. З.**

Зонная структура квазиодномерной планарной топологической сверхрешётки

B23 **Атласов В. Р.,** Свинцов Д. А.

Термоэлектрические свойства графена в условиях сильного электрон-дырочного рассеяния

B24 **Бельков В. В.,** Молдавская М. Д., Голуб Л. Е., Ганичев С. Д.

Нелинейный электронный транспорт в теллурене

B25 Колотаева Е. Е., **Боев М. В.,** Кибис О. В.

Роль межчастичных столкновений в транспортных свойствах двухкомпонентных двумерных электронных систем

B26 **Брагинский Л. С.,** Энтин М. В.

Теория низкоразмерных двумерных систем с субволновым масштабом

B27 **Герштейн Я. А.,** Жаркова Е. В., Титова М. И., Кащенко М. А., Кощей Б. В., Жидков Н. С., Ханас А. Р., Титова Е. И.

Мемристоры на основе гексагонального нитрида бора: влияние дефектов, создаваемых сфокусированным ионным пучком

B28 **Даутов А. М.,** Алексеев П. А., Попов М. Е., Котляр К. П., Лендяшова В. В., Мельниченко И. А., Шугабаев Т., Дубровский В. Г., Цырлин Г. Э., Гридчин В. О.

Синтез и свойства III-N наноструктур на Ван-дер-Ваальсовых слоях *h*-BN

2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки

B29 Калентьева И. Л., **Дорохин М. В.,** Вихрова О. В., Ведь М. В., Здоровейщев А. В., Демина П. Б.

Магниторезистивные светоизлучающие диоды с углеродным слоем

B30 **Дорохин М. В.,** Кузнецов Ю. М., Дёмина П. Б., Байдусь Н. В., Здоровейщев А. В.

Влияние размерного квантования на термоэлектрические свойства полупроводников на примере гетероструктур In(Ga)As/GaAs

B31 **Зедоми Т. Э.,** Котова Л. В., Бурункова Ю. Э., Тарасов В. Е., Кочерешко В. П.

Фото- и термоиндуцированные эффекты оптической перестройки в гибких нанокомпозитах As_2S_3/Au

B32 Сотничук М. К., Криштопенко С. С., Соколов Т. А., Consejo C., Jouault B., Rodriguez J.-B., Tournié E., Хохлов Д. Р., Terre F., **Иконников А. В.**

Остаточная фотопроводимость в трехслойных квантовых ямах InAs/GaInSb

B33 **Караулов Д. А.,** Харин Н. Ю., Винниченко М. Я., Саркисян А. А., Фирсов Д. А.

Низкотемпературная фотопроводимость квантовых ям GaAs/AlGaAs в терагерцовой области спектра в электрическом поле

B34 Харин Н. Ю., **Караулов Д. А.,** Винниченко М. Я., Фирсов Д. А., Саркисян А. А.

Терагерцовая и инфракрасная фотолюминесценция в электрическом поле в квантовых ямах GaAs/AlGaAs

B35 Шандыба Н. А., Духан Д. Д., Махов И. С., Еременко М. М., **Кугаевский А. Д.,** Шаров В. А., Солодовник Н. Е., Крыжановская Н. В., Балакирев С. В., Солодовник М. С.

Влияние режимов роста высокоплотных массивов ННК GaAs на их оптические и структурные свойства

B36 **Лакунцова О. Е.,** Климко Г. В., Седова И. В., Семенов А. Н., Веретенников А. И., Прасолов Н. Д., Мясоедов А. В., Сорокин С. В.

Гетероструктуры с квантовыми точками InAs/InGaAs и сверхтонким метаморфным буферным слоем для однофотонных источников телекоммуникационного С-диапазона

B37 Пилипенко Е. А., Драгунов И. Е., Семенюк Ю. А., Балабан А. В., **Любчанский И. Л.**

Электронные спектры одномерных сверхрешеток со сложной элементарной ячейкой: мультикомпонентные структуры

2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки

B38

Сёмкин В. А., Капралов К. Н., **Мазуренко И. М.,** Кащенко М. А., Морозов А. Д., Матюшкин Я. Е., Бочаров А. Ю., Свинцов Д. А.

Универсальная реконструктивная поляриметрия с помощью инфракрасных фотодетекторов на основе структур графен-металл

B39

Матиенко Д. А., Иконников А. В., Кунцевич А. Ю.

Фотоотклик проводимости CVD-графена в видимом и ближнем ИК диапазонах

B40

Махмудиан М. М., Махмудиан М. М., Энтин М. В., Гисматулин А. А., Гриценко В. А.

Кулоновское отталкивание и вигнеровская кристаллизация локализованных электронов в HfO_2

B41

Машинский К. В., Фатеев Д. В., Попов В. В.

Зарождение краевого плазмона в графеновом прямоугольнике

B42

Морозов М. Ю., Фатеев Д. В., Попов В. В.

Торцевое терагерцовое излучение краевым плазмоном в графеновой микроленте

B43

Неверов В. Н., Гудина С. В., Сандаков Н. С., Шелушинина Н. Г.

Универсальность критических индексов для переходов плато–плато квантового эффекта Холла

B43a

Гудина С. В., Брусникова А. А., **Неверов В. Н.,** Шелушинина Н. Г., Михайлов Н. Н.

Критическое поведение проводимости в структуре с двойной квантовой ямой на основе HgTe со слоями критической толщины

B44

Никонов А. В., Заболотных А. А.

Краевой плазмон, экранированный боковым металлом

B45

Осколкова Т. О., Koo Y., Шубник А. А., Честнов И. Ю., Park K. D., Иорш И. В., Кравцов В.

Управление населённостью экситонных состояний в муаровом потенциале при комнатной температуре

B46

Зыбцев С. Г, **Покровский В. Я.,** Никитин М. В., Казанцева Н. В.

Влияние продольного растяжения и поперечного сжатия на кристаллическую структуру и динамику ВЗП в TaS_3

2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки

B47 Лончаков А. Т., Бобин С. Б., **Попов С. Д.,** Пряничников С. В., Якунин М. В.

Наблюдение кирального магнитного эффекта в объемном *n*-HgTe с низкой концентрацией электронов

B48 **Попов С. Д.,** Неверов В. Н., Гудина С. В., Сандаков Н. С., Туруткин К. В., Груздев Н. Б., Васильевский И. С., Виниченко А. Н.

Влияние типа контакта на возникновение напряжения в режиме квантового эффекта Холла при отсутствии тока через образец

B49 **Поташин С. О.,** Горбенко И. В., Качоровский В. Ю.

Эффект храповика в латеральном плазмонном кристалле: гигантское усиление за счёт интерференции «светлых» и «тёмных» мод

B50 **Саитов Ш. Р.,** Колпаков М. А., Васильев Р. Б., Смирнов А. М., Манцевич В. Н.

Фотоэлектрические свойства и состояния ловушек в запрещенной зоне пленки нанопластинок CdSe/CdS

B51 **Тараненко А. В.,** Милёхин И. А., Фёдоров В. В., Дворецкая Л. Н., Мухин И. С., Тумашев В. С., Гайдук А. Е., Милёхин А. Г.

Плазмон-усиленное комбинационное рассеяние света и фотолюминесценция от нанопроволок GaP

B52 **Тараненко А. В.,** Салангина Е. В., Милёхин И. А., Нирандждан К., Милёхин А. Г.

Комбинационное рассеяние света, усиленное металлизированным зондом атомно-силового микроскопа, от наноалмазов

B53 **Тюменцев М. М.,** Минакова В. Е., Федотов Н. И., Зайцев-Зотов С. В.

Расщепление фазового перехода в 1T-TaS_2 под действием одноосного растяжения

B54 **Фадеев М. А.,** Янцер А. А., Кудрявцев К. Е., Румянцев В. В., Уточкин В. В., Разова А. А., Мажукина К. А., Дубинов А. А., Алешкин В. Я., Михайлов Н. Н., Морозов С. В.

Экспериментальная оценка внутренних потерь в гетероструктуре с квантовыми ямами на основе HgTe/$Cd_xHg_{1-x}Te$

B55 **Фадеев М. А.,** Янцер А. А., Кавеев А. К., Федоров В. В., Минив Д. В., Мухин И. С., Морозов С. В.

Фотолюминесцентные свойства нитевидных нанокристаллов InAsBiN на Si подложках

2D и 1D системы, гетероструктуры, сверхрешетки

B56 **Фадеев М. А.,** Янцер А. А., Шенгуров Д. В., Астраханцева А. С., Морозова Е. Е., Горбенко И. В., Бушуйкин П. А., Гусихин П. А., Морозов С. В., Качоровский В. Ю., Муравьев В. М.

Спектроскопия поглощения двухмерных плазменных кристаллов на основе квантовых ям HgTe/CdHgTe и GaAs/AlGaAs

B57 **Фролов Д. А.,** Шамирзаев Т. С., Манцевич В. Н., Аверкиев Н. С., Петрушков М. О., Емельянов Е. А., Преображенский В. В., Путято М. А., Семягин Б. Р., Яковлев Д. Р., Bayer M.

Линейная поляризация зона–акцепторной ФЛ гетероперехода GaAs/AlAs

B58 **Хазанова С. В.,** Горшков А. П., Бобров А. И., Панфилов А. С.

Изучение штарковского сдвига в гетероструктурах AIIIBV различного дизайна

B59 **Хахулин С. А.,** Фирсов Д. Д., Чуманов И. В., Комков О. С., Мынбаев К. Д., Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н.

Оптическая модуляционная спектроскопия квантово-размерных структур на основе CdHgTe в среднем ИК диапазоне

B60 Иванов А. А., **Чалдышев В. В.,** Сахаров А. В., Николаев А. Е., Артеев Д. С., Цацульников А. Ф.

Резонансные брэгговские структуры на основе сдвоенных квантовых ям III-N в периодической сверхъячейке

B61 **Шабанов А. В.,** Свинцов Д. А

Сдвиг Лэмба уровней Ландау в двумерных электронных системах в многомодовом резонаторе

B62 **Янцер А. А.,** Фадеев М. А., Кудрявцев К. Е., Румянцев В. В., Уточкин В. В., Разова А. А., Мажукина К. А., Дубинов А. А., Алешкин В. Я., Михайлов Н. Н., Морозов С. В.

Генерация стимулированного излучения в области 3.5-4.5 мкм при комнатной температуре в гетероструктурах с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe

B63 **Янцер А. А.,** Фадеев М. А., Астраханцева А. С., Шуваев А. М., Гусихин П. А., Кукушкин И. В., Муравьев В. М., Морозов С. В.

Электромагнитный плазменный резонанс в GaAs мембранах с двумерным электронным слоем

0D

B64 **Батаев М. Н.,** Кучинов Д. А., Кузнецова М. С., Игнатьев И. В., Колобкова Е. В.

Влияние легирования перовскитных нанокристаллов $CsPb(Br, Cl)_3$ на эффективность синей фотолюминесценции

0D системы

B65 Александров И. А., **Гуляев Д. В.**

Механизмы диффузии элементов третьей группы в InGaAs

B66 Свит К. А., Александров И. А., **Гуляев Д. В.**

Природа люминесценции квантовых точек $Cd_xZn_{1-x}S$, синтезированных в матрице бегеновой кислоты

B67 **Зибинский А. Л.,** Смирнов Д. С.

Конкуренция квантовых измерений и прыжков в спиновой динамике заряженных квантовых точек

B68 **Игнатьев И. В.,** Кузнецова М. С., Батаев М. Н., Петухов Н. А., Колобкова Е. В.

Монослойные флуктуации размеров перовскитных нанокристаллов в стеклянной матрице

B69 **Кочерешко В. П.,** Котова Л. В.

Влияние поперечного магнитного поля на продольный *g*-фактор экситона в квантовой яме/точке

B70 Барышников К. А., **Крайнов И. В.**

Поляризация люминесценции экситона в одиночной квантовой точке при нерезонансном возбуждении через фононы

B71 **Кулебякина Е. В.,** Скориков М. Л., Белых В. В., Жуков Е. А., Яковлев Д. Р., Батаев М. Н., Кузнецова М. С., Колобкова Е. В.

Динамика экситонной рекомбинации в перовскитных нанокристаллах $CsPbI_3$ в матрице фторфосфатного стекла: переход от сильного к слабому размерному квантованию

B72 **Ревин А. А,** Конаков А. А.

Автолокализованные дырки в нанокристаллах β-Ga_2O_3

B73 **Русских К. И.,** Головатенко А. А., Родина А. В.

Влияние сферической гетерограницы и поверхности на оптические свойства нанокристаллов InP/ZnSe и InP

Спин-зависимые явления

B74 **Андреева С. А.,** Щепетильников А. В., Орлов О. В., Николаев Г. А., Хисамеева А. Р., Кукушкин И. В.

Псевдоспиновый ферромагнетизм в AlAs: исследование квантовых фазовых переходов методом ЭПР

B75 **Борисов П. С.**

Корреляционные свойства двух кубитов, соединённых спиновой цепочкой

B76 **Вальков А. В.,** Матвеев А. А., Сафин А. Р., Никитов С. А.

Управление нелинейностью скирмионного осциллятора внешним магнитным полем

B77 **Жиляков В. Л.,** Югова И. А., Головатенко А. А., Яковлев Д. Р., Колобкова Е. В.

Оптическая ориентация и оптическое выстраивание экситонов в ансамбле случайно ориентированных перовскитных нанокристаллов

B78 **Козлов И. И.,** Козырев Н. В., Намозов Б. Р., Кусраев Ю. Г.

Магнитоиндуцированная циркулярная поляризация резонансного комбинационного рассеяния света с испусканием оптических фононов в двойных квантовых ямах CdTe/CdMnTe

B79 **Рагоза М. Д.,** Некрасов С. В., Головатенко А. А., Михайленко Н. О., Кусраев Ю. Г.

Анизотропия эффекта оптической ориентации в непрямых в *k*-пространстве квантовых точках (In,Al)As/AlAs

B80 **Романова О. Б.,** Аплеснин С. С., Ситников М. Н., Минчукова О. Ф., Римский Г. С., Желудкевич А. Л., Удод Л. В., Живулько А. М.

Магнитотранспортные эффекты в интерметаллических соединениях $MnZn_{1-x}Cr_xSb$

B81 **Удод Л. В.,** Аплеснин С. С., Ситников М. Н., Романова О. Б., Минчукова О. Ф., Римский Г. С.,Желудкевич А. Л., Живулько А. М.

Электронные переходы в хром замещенном антимониде марганца-цинка

B82 **Хомицкий Д. В.,** Дорохин М. В., Ведь М. В., Малышева Е. И.

Кинетическая модель спин-зависимой фотоЭДС для квантовой ямы с близкорасположенным магнитным слоем

B83 **Хомицкий Д. В.,** Запруднов Н. А.

Динамическая локализация проекции спина в двойной квантовой точке с помощью бигармонического электрического поля

Примеси и дефекты

B84 Таврунова Н. Ю., Сарычев М. Н., **Жевстовских И. В.,** Коростелин Ю. В., Аверкиев Н. С., Гудков В. В.

Динамические и статические свойства ян-теллеровской подсистемы в кристалле ZnTe:Cr

B85 **Зазымкина Д. А.,** Аминев Д. Ф., Николаев С. Н., Кривобок В. С.

Нефелоксетический эффект в широкозонных материалах кубической сингонии, легированных Fe и V

B86 Стрельчук А. М., Козловский В. В., **Лебедев А. А.**

Влияние облучения электронами высокой дозой и последующего отжига на вольт-амперные характеристики диодов Шоттки на основе карбида кремния

B87 **Миронов С. А.,** Калинушкин В. П., Уваров О. В., Гладилин А. А., Юрьев В. А., Гаврищук Е. Е., Иконников В. Б., Савин Д. В., Курашкин С. В.

Исследование люминесцентных и рекомбинационных характеристик границ зерен в CVD-ZnSe

B88 Дворецкий С. А., **Михайлов Н. Н.,** Варавин В. С., Ремесник В. Г., Ступак М. Ф., Макаров С. Н., Елесин А. Г.

Легированные индием широкозонные слои HgCdTe и кристаллическое состояние структуры

B89 **Николаев С. Н.,** Екимов Е. А., Усманов И. И., Зазымкина Д. А., Чернопицский М. А., Кривобок В. С.

Спектроскопия возбужденных состояний Tm^{3+} в матрице SnS_2

B90 **Панкратов С. А.,** Кусакина Д. Д., Трифонов А. С., Шорохов В. В., Крупенин В. А., Преснов Д. Е.

Высокотемпературные методы формирования одноэлектронных структур в слое легированного бором кремния

B91 **Скворцова А. А.,** Каленков С. Г.

Магнитное управление пропусканием света в кристаллах фосфида галлия

B92 Василенко А. П., Дерябин А. С., Колесников А. В., Никифоров А. И., Лошкарев И. Д., Соколов Л. В., Турцев Е. С., **Фрицлер К. Б.,** Шеховцов А. С.

Исследование дислокационной структуры эпитаксиальных слоев Ge на Si (001) методами селективного травления и высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии

Топология в полупроводниках

B93

Аплеснин С. С., Романова О. Б., Удод Л. В., Ситников М. Н., Харьков А. М., Никитинский О. С., Черемных Н. А., Римский Г. С., Желудкевич А. Л., Живулько А. М.

Акустоэлектрический эффект в полуметаллах $MnZn_{1-x}Cr_xSb$

B94

Баженов А. О., Степина Н. П., Шумилин А. В., Ненашев А. В., Ищенко Д. В., Терещенко О. Е.

Моделирование магнитных переходов в конечных многослойных структурах магнитного топологического изолятора $MnBi_2Te_4$

B95

Лончаков А. Т., **Бобин С. Б.,** Попов С. Д., Пряничников С. В., Якунин М. В.

Особенности поперечного магнитотранспорта в объемном *n*-HgTe с низкой электронной плотностью

B96

Борисов И. М., Галиуллин А. А., Кунцевич А. Ю.

Методика получения и исследования топологических электронных свойств 1T'-фазы MoS_2

B97

Естюнин Д. А., Макарова Т. П., Бокай К. А., Филянина М. В., Голяшов В. А., Фролов А. С., Кох К. А., Терещенко О. Е., Шикин А. М.

Аномальный перенос заряда при адсорбции щелочных металлов в топологических изоляторах на основе $MnBi_2Te_4$

B98

Катков Д. С., Парфенов М. В., Бурмистров И. С.

Микроскопическая модель хиральных фермионов для спинового квантового эффекта Холла

B99

Лукманова Р. М., Кон И. А., Минакова В. Е., Зайцев-Зотов С. В.

Управление топологическими состояниями в $TaSe_3$

B100

Ненашев А. В., Зиновьева А. Ф., Зиновьев В. А., Кацюба А. В., Володин В. А., Лошкарев И. Д., Спесивцев Е. В., Двуреченский А. В.

Синтез однородного массива нанокристаллов $CaSi_2$, встроенных в слой CaF_2 на подложке Si (111)

B101

Петякина А. С., Голяшов В. А., Терещенко О. Е.

Изучение электронной структуры поверхности и транспортных свойств тонких проводящих слоев (111) PbSnTe

B102

Ищенко Д. В., Супрун С. П., Кырова Е. Д., Федосенко Е. В., Голяшов В. А., Степина Н. П., Сухих А. С., **Терещенко О. Е.**

Рост плёнок топологических изоляторов на основе Bi_2Te_3 методом МЛЭ

	Понедельник 5 октября	Вторник 6 октября		Среда 7 октября		Четверг 8 октября		Пятница 9 октября
	Холл главного корпуса	**Зал А**	**Зал Б**	**Зал А**	**Зал Б**	**Зал А**	**Зал Б**	**Зал А**
9:30	Регистрация участников	2D и 1D системы 3	Поверхность, пленки, слои	2D и 1D системы 5	Спин-зависимые явления 1	Фотонные кристаллы 2	Топология 2	Спин-зависимые явления 2
10:00	**Зал А**							
10:30	**Открытие конференции**							
11:00	Пленарное заседание 1							
11:15		**Кофе-брейк**		**Кофе-брейк**		**Кофе-брейк**		**Кофе-брейк**
11:30		2D и 1D системы 4	0D системы	Мемориальная сессия памяти Р. А. Суриса		Примеси и дефекты	Атомарно-тонкие ПП	ПП приборы 2
12:30	**Обед**							
12:40								Пленарное заседание 2
13:35	**Зал А**	**Зал Б**		**Обед**		**Обед**		**Закрытие конференции**
14:00	2D и 1D системы 1	Топология 1						
14:30								
15:00			ВЧ явления	Фотонные кристаллы 1				
15:45	**Кофе-брейк**							
16:00	2D и 1D системы 2	Объемные ПП 1				Мемориальная сессия памяти В. Б. Тимофеева		
16:45			**Кофе-брейк**					
17:00			Объемные ПП 2	ПП приборы 1		Доклады спонсоров		
17:40	**Стендовая сессия 1** — Поверхность, пленки слои; — ВЧ явления; — Атомарно-тонкие полупроводники; — Фотонные кристаллы; — Полупроводниковые приборы.		**Стендовая сессия 2** — Объемные полупроводники; — 2D и 1D системы; — 0D системы; — Спин-зависимые явления; — Примеси и дефекты; — Топология в полупроводниках.	**Экскурсия в музей «Атом» на ВДНХ**		Экскурсии по ФИАН		
18:30	**Приветственный фуршет**					**Банкет**		